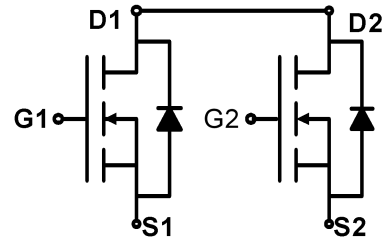




描述

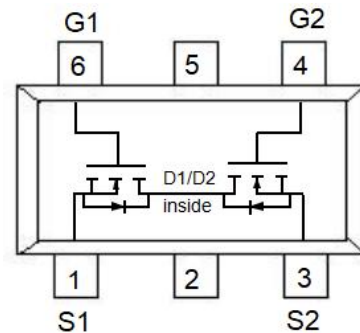
- 20V MOSFET 技术
- 极低的导通电阻
- 超快的开关速度
- Drain(2、5脚内部连接金属线连接)
- 封装: SOT23-6



电路结构图

应用

- 用于单节锂电池保护 (仅限于单节锂电池保护板使用)



顶视图 (含电路结构)
(D1/D2 Pin2 和 Pin5 不连出)

最大额定值和热特性 (Ta = 25°C, 除非另有说明。)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	20	V
栅源电压	V_{GS}	± 10	V
漏极电流, $V_{GS} = 4.5V, @T_a = 25^\circ C$	I_D	6	A
漏极电流, $V_{GS} = 4.5V, @T_a = 70^\circ C$	I_D	4.8	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	20	A
工作结温	$T_{J,}$	-55 to 150	$^\circ C$
存储温度范围	T_{stg}	-55 to 150	$^\circ C$

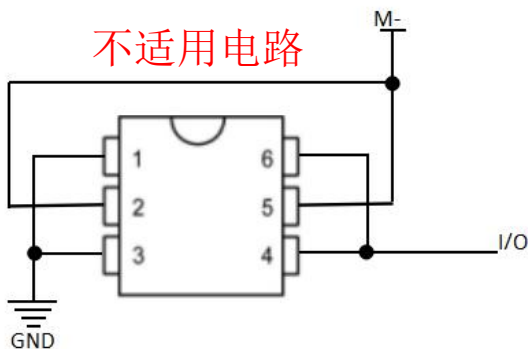


电特性 ($T_j = 25^\circ\text{C}$, 除非另有注明)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS} = 0, I_D = 250\mu\text{A}$	19.5	20.5		V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS} = 16\text{V}, V_{GS} = 0$	-	-	1	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 10\text{V}, V_{DS} = 0$	-	-	± 1	μA
击穿电压温度系数	$\frac{\Delta BV_{DSS}}{\Delta T_j}$	参考点 25°C $I_D = 1\text{mA}$	-	0.03	-	$\text{V}/^\circ\text{C}$
栅极门限电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu\text{A}$	0.4	0.65	1.0	V
漏源导通电阻 (双 MOS)	$R_{SS(ON)}$	$V_{GS} = 4.5\text{V}, I_D = 6\text{A}$	-	35	45	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS} = 3.8\text{V}, I_D = 3\text{A}$	-	39	52	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS} = 2.5\text{V}, I_D = 3.0\text{A}$	-	44	56	$\text{m}\Omega$
正向跨导	g_{fs}	$V_{DS} = 5\text{V}, I_D = 4.5\text{A}$	-	10	-	S
源漏正向导通电压	V_{SD}	$I_S = 1.0\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$	-	0.72	1.2	V

注意

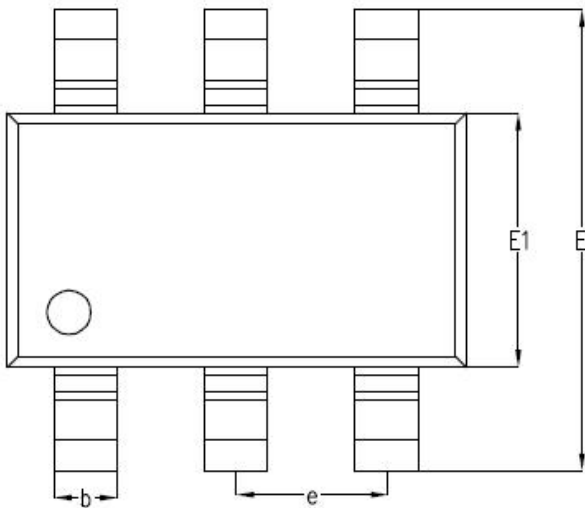
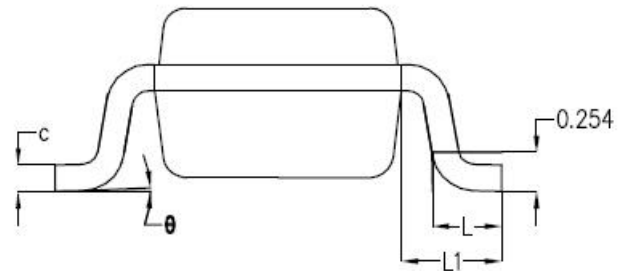
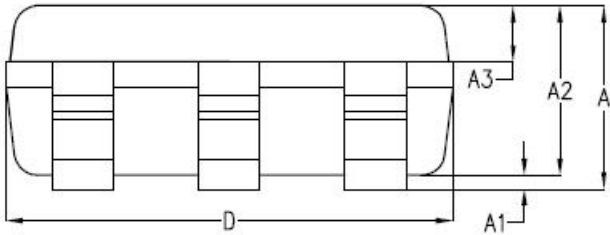
不适用电路如下! 不可当10mohm MOSFET并联使用





封装信息

SOT23-6



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.19	1.24
A1	-	0.05	0.09
A2	1.05	1.10	1.15
A3	0.31	0.36	0.41
b	0.35	0.40	0.45
c	0.12	0.17	0.22
D	2.85	2.90	2.95
E	2.80	2.90	3.00
E1	1.55	1.60	1.65
e	0.95BSC		
L	0.37	0.45	0.53
L1	0.65BSC		
θ	0°	2°	8°